

1. 芯片特征

- (1) SIPOS和GPP双层钝化保护工艺
- (2) 单台面外沟槽工艺
- (3) $V_{RRM} \geq 1000V$
- (4) 金属组合一：正面金属AL+背面金属Ti-Ni-Ag
- (5) 金属组合二：双面金属Ti-Ni-Ag

2. 芯片尺寸

- (1) 0.65mm×0.65mm (26mil)
- (2) 满版点数：17342只/4英寸晶圆

3. 主要用途

- (1) 整流电源
- (2) 其他整流应用



4. 产品极限参数

参数名称	符号	单位	测试条件	数值
反向重复峰值电压	V_{RRM}	V	$T_j=25^\circ\text{C}, I_{RRM}=5\mu\text{A}$	1000
反向不重复峰值电压	V_{RSM}	V	$T_j=25^\circ\text{C}, I_{RRM}=5\mu\text{A}$	1100
正向平均电流	$I_{F(AV)}$	A		0.5
正向浪涌电流	I_{FSM}	A	$tp=10\text{ms}, \sin 180^\circ, T_j=25^\circ\text{C}$	10
电流时间积分	I^2t	A^2S	$tp=10\text{ms}, \sin 180^\circ, T_j=25^\circ\text{C}$	0.5
结温范围	T_j	$^\circ\text{C}$		-60~150

5. 其他检查标准

参数名称	符号	单位	测试条件	最小值	典型值	最大值	检验数量
反向漏电流	I_R	μA	$V_R=V_{RRM}$	$T_j=25^\circ\text{C}$	—	1	抽检(5%)
				$T_j=150^\circ\text{C}$	—	150	
正向压降	V_F	V	$I_F=0.5\text{A}, T_j=25^\circ\text{C}$	—	1	1.2	

6. 芯片结构

名称	符号	单位	尺寸
芯片尺寸	U	mm	0.65 ± 0.05
沟槽尺寸	W	mm	0.41 ± 0.1
金属尺寸	X	mm	0.37 ± 0.1
芯片厚度	Y	μm	230 ± 10
沟槽深度	Z	μm	85 ± 20
AL金属层厚度		μm	5 ± 1
Ti-Ni-Ag金属层厚度		μm	1.0~1.5

